半導体超薄膜作製とその超高速非線形光学応答

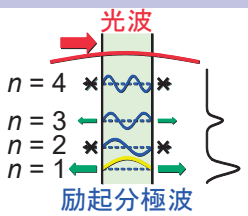
関連するSDGsの国際目標

工学部　電子システム工学科　　准教授　　一宮　正義
研究分野　：デバイス工学、光物性、超高速分光

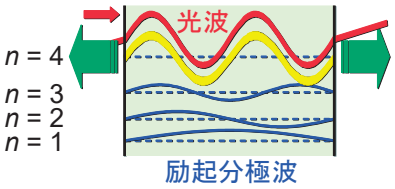
光を照射した瞬間だけ物質の性質が変わり、さらに別に照射する光に対する応答特性が変化することを非線形光学効果と呼びます。この効果は様々な分野で応用が可能ですが、特に光通信などにおける信号のオン・オフや経路変化を別の制御光を照射することにより行う全光型ゲートデバイスは、電気的制御より圧倒的に高速かつ省エネルギーであるため、将来の大容量光情報処理技術を加速させるキーデバイスとしてその実現が期待されています。

■高品質微小結晶における光と分極の特異な相互作用

大きな非線形光学効果を得るためには、照射する光のエネルギーを物質の電子を励起するエネルギーに共鳴させることが望ましいのですが、共鳴によって得たエネルギーは緩和するまでに長い時間を要するという問題があります。このようなトレードオフを回避しつつ高効率かつ高速な光ゲートデバイスを実現するために、様々な材料、構造、新しい物理機構の研究が行われています。もし結晶性が十分に高い微小構造を作ることができれば、光によって励起された電子の波動が乱されることなく数百ナノメートルにわたって広がるため、厚さなどの条件が適切であれば光の波と励起電子の波が数波長にわたって整合すると考えられています。このときの特異的に強い相互作用によって、電子励起状態が光を放射しながら超高速で緩和するという理論研究成果に私達は着目し、半導体薄膜試料の高品質化と超高速非線形光学応答の観測にチャレンジしています。



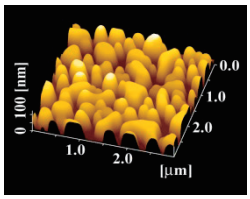
ナノ構造における光と電子励起状態



結晶性が十分に高い系での光と電子励起状態

■新奇手法による高品質CuCl薄膜の作製

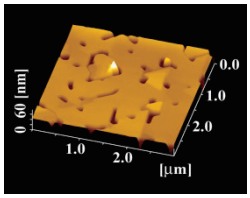
本研究では光との相互作用が強いCuClという物質を取り扱っていますが、作製技術が成熟しているGaAs等のIII-V族に比べてI-VII族化合物で高品質な薄膜を作製するのには多くの課題がありました。ところが、試行錯誤の末、真空蒸着法の１つで成長層厚を原子層レベルで精密に制御することができる分子線エピタキシー法において、電子ビームを照射することによって膜質を飛躍的に向上させる技術の開発に成功しました。現在は、薄膜の品質や膜厚制御精度の向上はもちろんのこと、潮解性の高いCuClをコーティング等により空気中で使用可能にする技術の確立も目指しています。



従来の製法によって作製したCuCl薄膜の表面原子間力顕微鏡(AFM)像

■超高速非線形光学応答の観測

超短パルスレーザーを用いて過渡回折格子を作成し、発生した信号光の時間による強度変化を測定することによって励起状態の緩和特性を調べることができます。高品質化に成功した薄膜試料においてこの測定を行ったところ、輻射緩和する時間や複数モードの干渉を示すビート構造が理論計算によって導き出された結果と 極めて良く一致することが分かり、電子励起波動・光波動の重なりによる超高速応答が起きていることが確認できました。 得られた輻射緩和時間は１００フェムト秒（１０００兆分の１秒）クラスに達しており、従来の高速輻射緩和とされたデータよりさらに２～３桁速い結果となっています。励起状態の波が格子振動などによって乱されてしまう現象は温度が高いほど速く起こります。これが室温などの高温領域で光学応答の効率が激減する原因となっており、光ゲートデバイス等への応用に向けての大きな課題となっています。しかし、輻射緩和が数十フェムト秒程度で起こってしまえば、波が乱されるよりも速く高効率で非線形光学応答が起こると考えられます。このテーマでは、薄膜試料における厚さのコントロールとさらなる品質向上により数十フェムト秒級の超高速応答を実現することによって、室温をしのぐ高温領域における超高速・超高効率非線形光学応答の観測を最大の目標としています。



電子ビーム照射を取り入れた新奇製法により作製したCuCl薄膜の表面AFM像

